
Netz-Gleichrichterdiode
Rectifier Diode

D1030N

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltages	$T_{vj} = -25^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{ max}}$	V_{RRM}	2200 V 2400 V 2600 V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert maximum RMS on-state current		I_{FRMSM}	2040 A
Dauergrenzstrom average on-state current	$T_C = 100^{\circ}\text{C}$	I_{FAVM}	1030 A
Dauergrenzstrom average on-state current	$T_C = 55^{\circ}\text{C}, \theta = 180^{\circ}\sin, t_P = 10\text{ ms}$	I_{FAVM}	1490 A
Durchlaßstrom-Effektivwert RMS on-state current		I_{FRMS}	2340 A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_P = 10\text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, t_P = 10\text{ ms}$	I_{FSM}	17000 A 14500 A
Grenzlastintegral I^2t -value	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_P = 10\text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, t_P = 10\text{ ms}$	I^2t	1445 $10^3\text{A}^2\text{s}$ 1051 $10^3\text{A}^2\text{s}$

Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, I_F = 4,0\text{ kA}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, I_F = 1,0\text{ kA}$	V_F	max. 2,05 V max. 1,11 V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	$V_{(TO)}$	0,82 V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	r_T	0,28 mΩ
Durchlaßkennlinie on-state characteristic $V_F = A + B \cdot I_F + C \cdot \ln(I_F + 1) + D \cdot \sqrt{I_F}$	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	A= B= C= D=	3,973E-01 2,062E-04 3,005E-02 9,271E-03
Sperrstrom reverse current	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, V_R = V_{RRM}$	i_R	max. 40 mA

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	<u>Kühlfläche / cooling surface</u> beidseitig / two-sided, $\theta = 180^{\circ}\sin$ beidseitig / two-sided, DC Anode / anode, $\theta = 180^{\circ}\sin$ Anode / anode, DC Kathode / cathode, $\theta = 180^{\circ}\sin$ Kathode / cathode, DC	R_{thJC}	max. 0,038 $^{\circ}\text{C/W}$ max. 0,035 $^{\circ}\text{C/W}$ max. 0,064 $^{\circ}\text{C/W}$ max. 0,061 $^{\circ}\text{C/W}$ max. 0,085 $^{\circ}\text{C/W}$ max. 0,082 $^{\circ}\text{C/W}$
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	<u>Kühlfläche / cooling surface</u> beidseitig / two-sided einseitig / single-sided	R_{thCH}	max. 0,005 $^{\circ}\text{C/W}$ max. 0,010 $^{\circ}\text{C/W}$
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		$T_{vj\text{ max}}$	160 $^{\circ}\text{C}$
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c\text{ op}}$	-40...+160 $^{\circ}\text{C}$
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40...+160 $^{\circ}\text{C}$

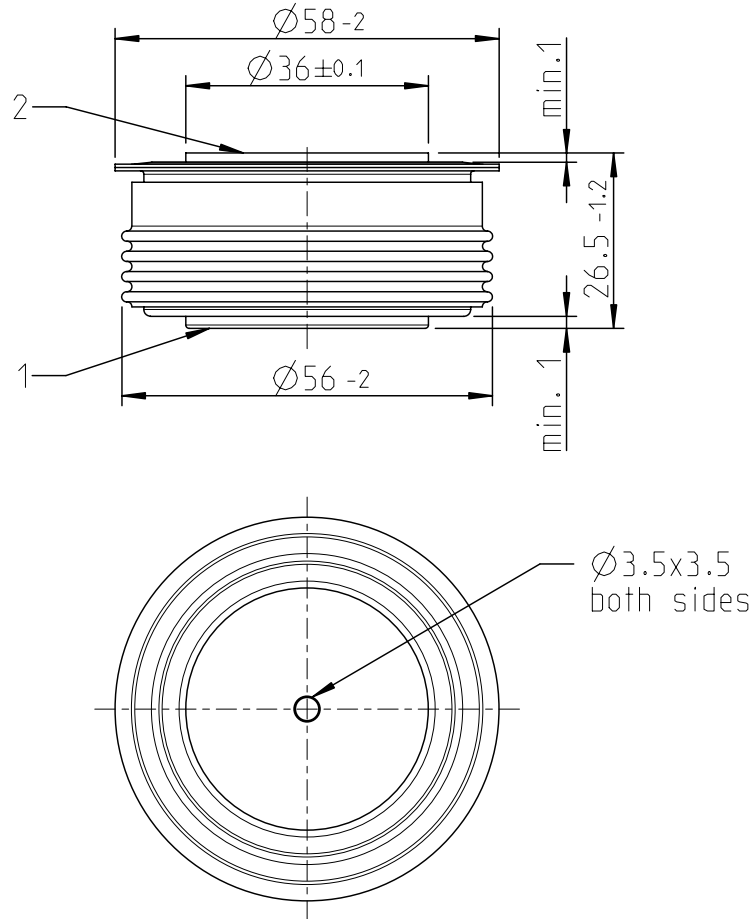
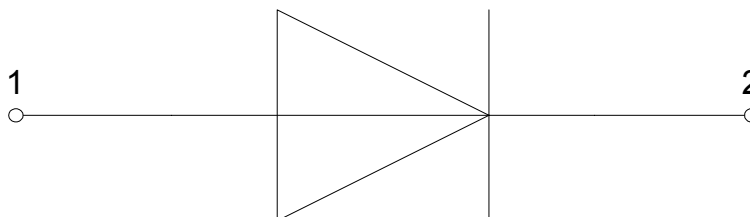
prepared by:	H.Sandmann	date of publication:	2008-09-15
approved by:	M.Leifeld	revision:	3.0


Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see annex			Seite 3 page 3	
Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact				
Anpreßkraft clamping force		F	10...24	kN
Gewicht weight		G	typ. 285	g
Kriechstrecke creepage distance			25	mm
Schwingfestigkeit vibration resistance	f = 50 Hz		50	m/s ²

Netz-Gleichrichterdiode
Rectifier Diode

D1030N

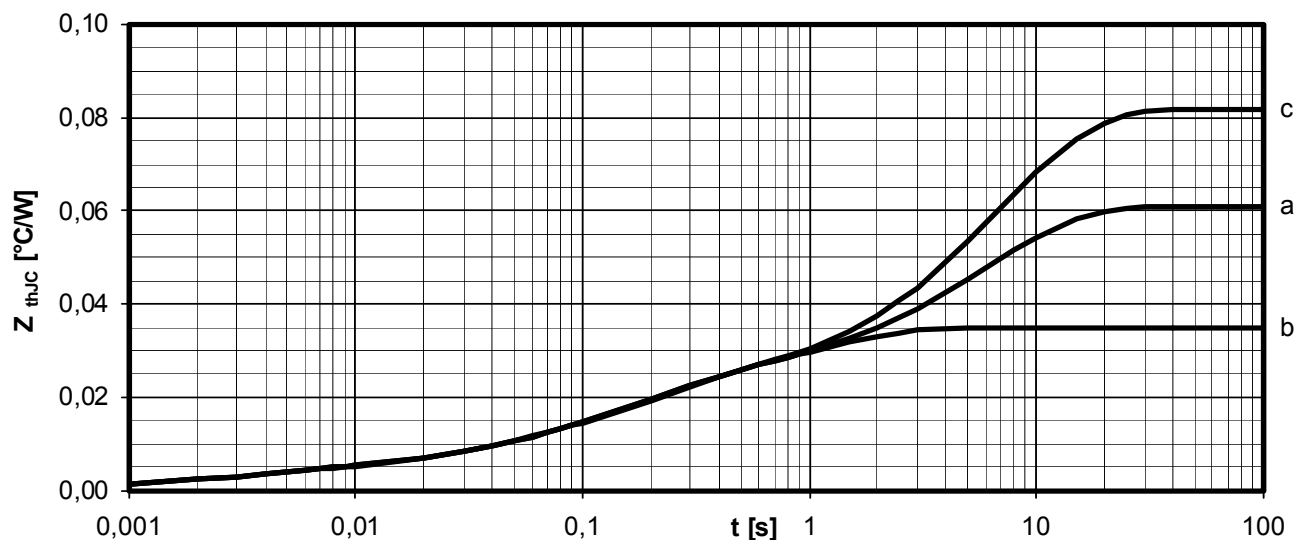
strike distance: 20mm
creepage distance: 25mmoverall height based
on contact pressure1: Anode/
Anode2: Kathode/
Cathode


Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} for DC

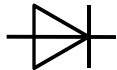
Kühlung / Cooling	Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
beidseitig two-sided	$R_{thn} [^{\circ}C/W]$	0,000170	0,003380	0,00429	0,01310	0,01406	-	-
	$\tau_n [s]$	0,000272	0,002610	0,04170	0,17300	0,99900	-	-
anodenseitig anode-sided	$R_{thn} [^{\circ}C/W]$	0,000221	0,003179	0,00357	0,01713	0,03690	-	-
	$\tau_n [s]$	0,000330	0,002600	0,02970	0,18200	5,83000	-	-
kathodenseitig cathode-sided	$R_{thn} [^{\circ}C/W]$	0,000218	0,003052	0,00216	0,01690	0,00537	0,0543	-
	$\tau_n [s]$	0,000328	0,002540	0,01790	0,14600	6,65000	6,8200	-

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$$


Transienter innerer Wärmewiderstand für DC / Transient thermal impedance for DC
 $Z_{thJC} = f(t)$

a - Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling
 b - Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling
 c - Kathodenseitige Kühlung / Cathode-sided cooling



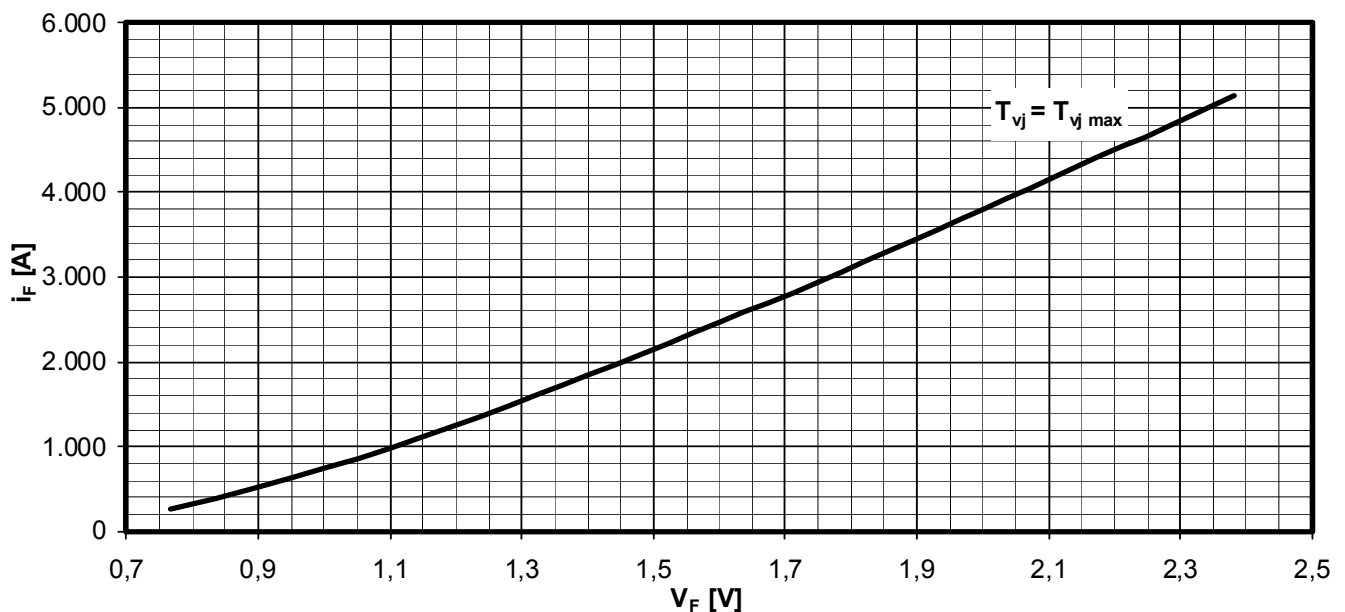
Erhöhung des $Z_{th\ DC}$ bei sinus- und rechteckförmigen Strömen für unterschiedliche Stromflusswinkel Θ
 Rise of $Z_{th\ DC}$ for sinewave and rectangular current for different current conduction angles Θ

$$\Delta Z_{th\ \Theta\ rec} / \Delta Z_{th\ \Theta\ sin}$$

Kühlung / Cooling		$\Theta = 180^\circ$	$\Theta = 120^\circ$	$\Theta = 90^\circ$	$\Theta = 60^\circ$	$\Theta = 30^\circ$
beidseitig two-sided	$\Delta Z_{th\ \Theta\ rec}$ [°C/W]	0,00437	0,00762	0,01014	0,01377	0,01948
	$\Delta Z_{th\ \Theta\ sin}$ [°C/W]	0,00277	0,00429	0,00642	0,00983	0,01588
anodenseitig anode-sided	$\Delta Z_{th\ \Theta\ rec}$ [°C/W]	0,00436	0,00756	0,01005	0,01364	0,01944
	$\Delta Z_{th\ \Theta\ sin}$ [°C/W]	0,00276	0,00424	0,00631	0,00963	0,01570
kathodenseitig cathode-sided	$\Delta Z_{th\ \Theta\ rec}$ [°C/W]	0,00436	0,00749	0,01002	0,01360	0,01940
	$\Delta Z_{th\ \Theta\ sin}$ [°C/W]	0,00276	0,00423	0,00629	0,00960	0,01567

$$Z_{th\ \Theta\ rec} = Z_{th\ DC} + \Delta Z_{th\ \Theta\ rec}$$

$$Z_{th\ \Theta\ sin} = Z_{th\ DC} + \Delta Z_{th\ \Theta\ sin}$$



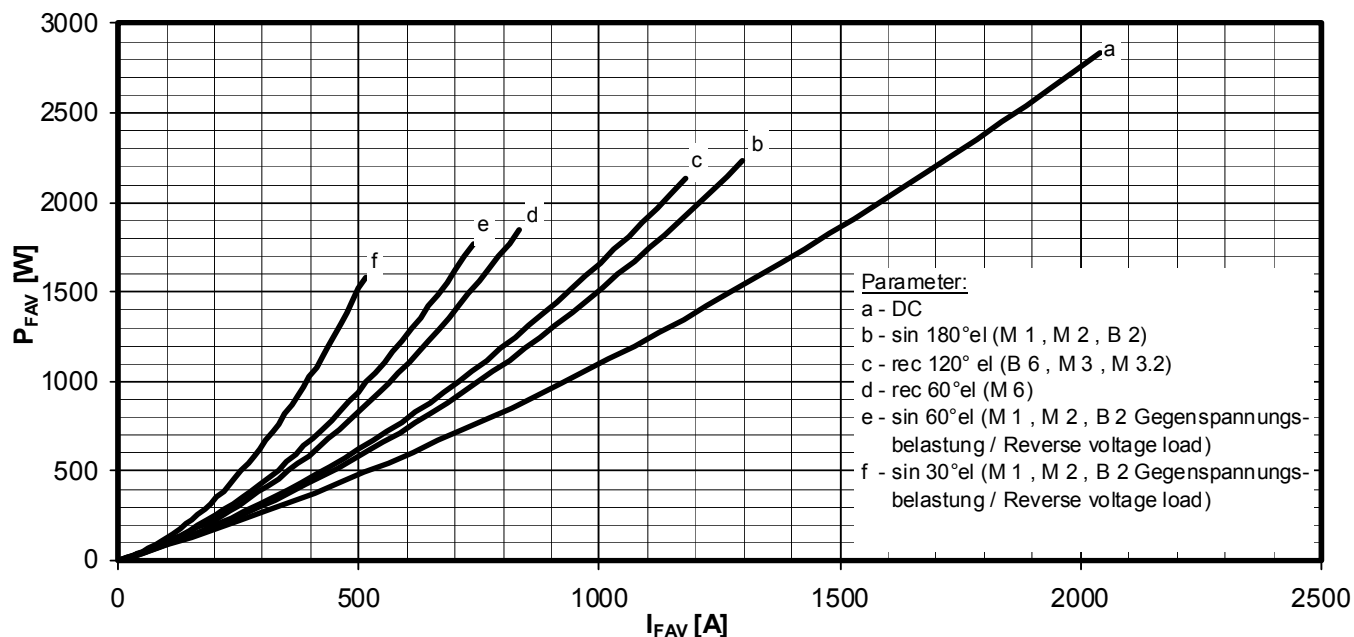
Grenzdurchlasskennlinie / Limiting on-state characteristic $i_F = f(V_F)$

$$T_{vj} = T_{vj\ max}$$



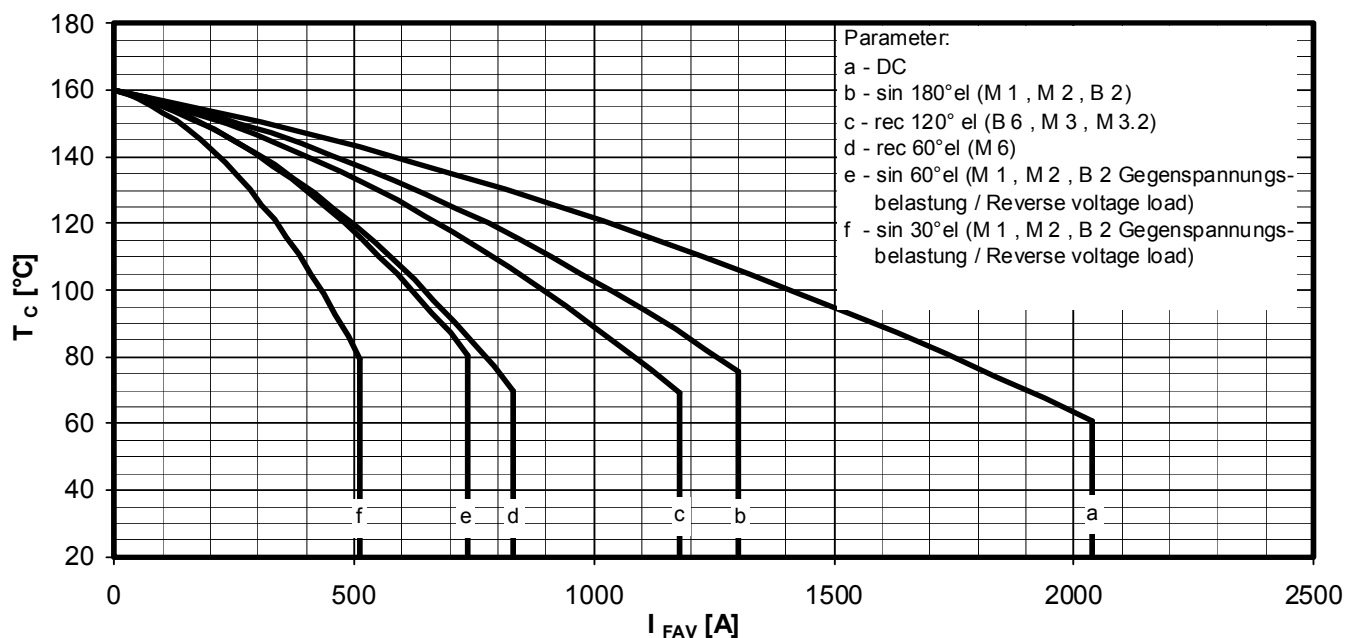
Netz-Gleichrichterdiode
Rectifier Diode

D1030N



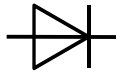
Durchlassverlustleistung / On-state power loss $P_{FAV} = f(I_{FAV})$

Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling



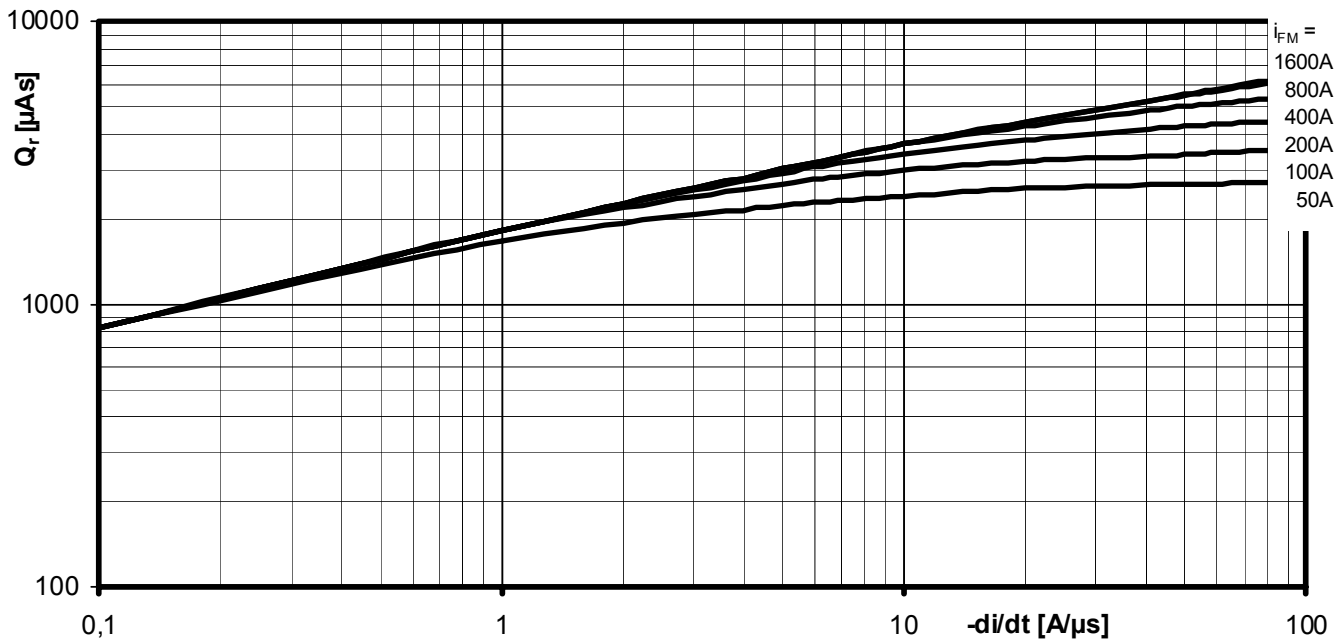
Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature $T_c = f(I_{FAV})$

Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling



Netz-Gleichrichterdiode
Rectifier Diode

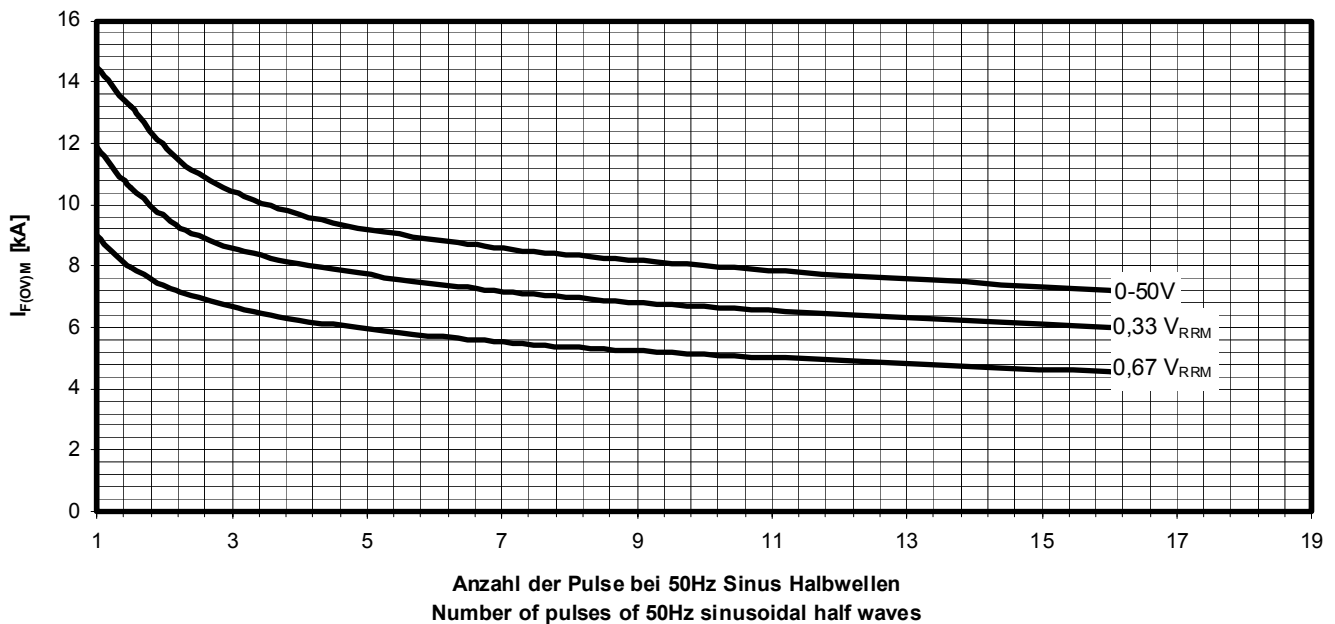
D1030N



Sperrverzögerungsladung / Recovered charge

$$Q_r = f(-di/dt)$$

$T_{vj} = T_{vjmax}$, $V_R \leq 0,5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$
RC-Glied / RC-Network: $R = 3,9\Omega$, $C = 1\mu F$



Typische Abhängigkeit des Grenzstromes $I_{F(OV)M}$ von der Anzahl für eine Folge von Sinus Halbwellen bei 50Hz. Parameter: Rückwärtsspannung V_{RM}
Typical dependency of maximum overload on-state current $I_{F(OV)M}$ as a number of a sequence of sinusoidal half waves at 50Hz. Parameter: peak reverse voltage V_{RM}
 $I_{F(OV)M} = f(\text{pulses}, V_{RM})$; $T_{vj} = T_{vjmax}$

N		Datenblatt / Data sheet	
Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode		D1030N	
Nutzungsbedingungen Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen. In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen. Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.infineon.com). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit. Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung. Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle - die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments; - den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen; - die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen. Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben. Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten. Terms & Conditions of usage The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application. This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics. Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.infineon.com). For those that are specifically interested we may provide application notes. Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you. Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend - to perform joint Risk and Quality Assessments; - the conclusion of Quality Agreements; - to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures. If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers. Changes of this product data sheet are reserved.			
IFBIP D AEC, 2008-09-15, H.Sandmann		A 47/08	Seite/page 8/8



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.